







	<h2>SI8461DB-T2-E1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI8461DB-T2-E1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI8461DB-T2-E1.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6011 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8461DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V MICROFOOT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6011 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 780mW (Ta), 1.8W (Tc) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, CSPBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	780mW (Ta), 1.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 1.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8461DB-T2-E1TR

SI8461DB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8461DB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8461DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8461DB-T2-E1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI8462AA-A-IS1R</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 1KV 6CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8461DB-T2-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8462AA-B-IS1</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 1KV 6CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8462AA-B-IS1R</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 1KV 6CH GEN PURP 16SOIC</p>
 <p><b>SI8462AA-A-IS1</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 1KV 6CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8461BB-B-IS1R</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8461BB-B-IS1</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8461DB</b> VISHAY SI8461DB VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

SI8440AB	SI8440AB-D-IS	SI8440BB	SI8440BB-D-IS	SI8440BC-D-IS
SI8441-A-IS	SI8441-BIS	SI8441-C-IS	SI8441AA	SI8441AA-D-IS
SI8441AB	SI8441AB-D-ISR	SI8441BB	SI8441BB-D-IS	SI8441BB-D-ISR
SI8441BC-D-IS	SI8442AA	SI8442AB	SI8442AB-C-ISR	SI8442BB
SI8442C-IS	SI8445-B-IS	SI8445-B-ISR	SI8451AB-B-IS1	SI8461DB
SI8461DB-T2-E1	SI8461DB-T2-E1.	SI8469DB-T2-E1	SI8469DB-T2-E1	SI8472DB-T2-E1
SI8472DB-T2-E1	SI8489EDB-T2-E1	SI8489EDB-T2-E1	SI8499DB-T2-E1	SI8499DB-T2-E1
SI8512-C-IM	SI8515-C-IM	SI8540-B-FW	SI8602AD-B-IS	SI8602AD-B-ISR
SI8620BC-B-ISR	SI8620ED-B-IS	SI8621EC-B-IS	SI8621EC-B-ISR	SI8622EC-B-SIR
SI8622ED-B-ISR	SI8631BC-B-IS1R	SI8631BD-B-IS	SI8631BD-B-ISR	SI8631EC-B-IS1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited